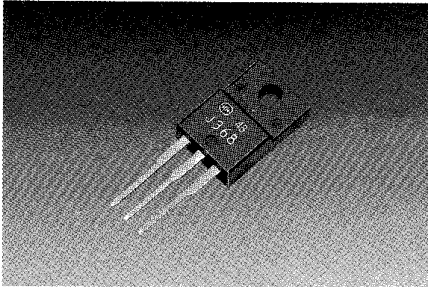
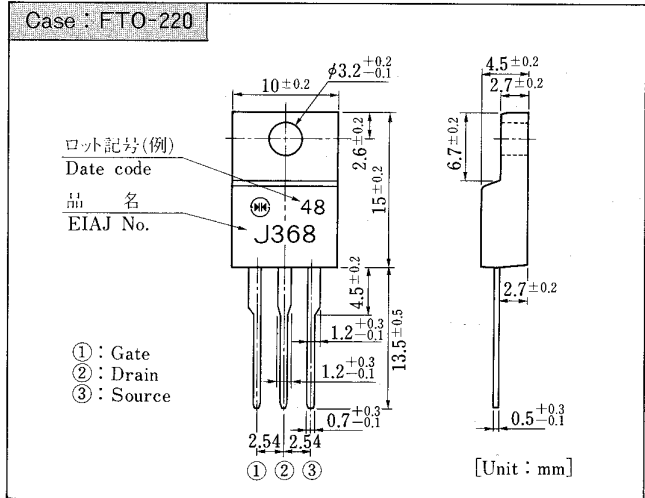


**2SJ368**  
(F5F6P)  
**-60V -5A**



■ 外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS



■ 定格表 RATINGS

■ 絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg		-55~150	°C
チャンネル温度 Channel Temperature	Tch		150	°C
ドレイン・ソース電圧 Drain-Source Voltage	V <sub>DSS</sub>		-60	V
ゲート・ソース電圧 Gate-Source Voltage	V <sub>GSS</sub>		±20	V
ドレイン電流 Continuous Drain Current	DC		-5	A
	Peak	パルス幅≤10μs, duty≤1/100 Pulse width≤10μs, Duty cycle≤1/100	-20	A
ソース電流(直流) Continuous Source Current (DC)	I <sub>S</sub>		-5	A
全損失 Total Power Dissipation	P <sub>T</sub>	T <sub>C</sub> =25°C	30	W
単発アバランシェ電流 Single pulse Avalanche Current	I <sub>AS</sub>	T <sub>C</sub> =25°C	-5	A
絶縁耐圧 Dielectric Strength	V <sub>dis</sub>	一括端子・ケース間, AC 1分間印加 Terminals to case, AC 1 minute	2	kV
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	(推奨値: 3 kg·cm) (Recommended torque: 3 kg·cm)	5	kg·cm

■ 電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (T<sub>C</sub>=25°C)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings			単位 Unit
			min.	typ.	max.	
ドレイン・ソース降伏電圧 Drain-Source Breakdown Voltage	V <sub>(BR)DSS</sub>	I <sub>D</sub> =-1mA, V <sub>GS</sub> =0V	-60			V
ドレイン遮断電流 Zero Gate Voltage Drain Current	I <sub>DSS</sub>	V <sub>DS</sub> =-60V, V <sub>GS</sub> =0V			-100	μA
ゲート漏れ電流 Gate-Source Leakage Current	I <sub>GSS</sub>	V <sub>GS</sub> =±20V, V <sub>DS</sub> =0V			±10	μA
順伝達コンダクタンス Forward Transconductance	g <sub>fs</sub>	I <sub>D</sub> =-2.5A, V <sub>DS</sub> =-10V	2.8	4.0		S
ドレイン・ソース間オン抵抗 Static Drain-Source On-state Resistance	R <sub>DS(on)</sub>	I <sub>D</sub> =-2.5A, V <sub>GS</sub> =-10V		0.15	0.25	Ω
ゲートしきい値電圧 Gate Threshold Voltage	V <sub>TH</sub>	I <sub>D</sub> =-1mA, V <sub>DS</sub> =-10V	-1.0	-1.5	-2.0	V
ソース・ドレイン間ダイオード順電圧 Source-Drain Diode Forward Voltage	V <sub>SD</sub>	I <sub>S</sub> =-2.5A, V <sub>GS</sub> =0V			-1.5	V
熱抵抗 Thermal Resistance	θ <sub>jc</sub>	接合部・ケース間 Junction to case			4.16	°C/W
ゲートチャージ特性 Gate Charge Characteristics	Q <sub>g</sub>	V <sub>GS</sub> =-10V, I <sub>D</sub> =-5A, V <sub>DD</sub> =-48V		-27		nC
入力容量 Input Capacitance	C <sub>iss</sub>			630		pF
帰還容量 Reverse Transfer Capacitance	C <sub>rss</sub>	V <sub>DS</sub> =-10V, V <sub>GS</sub> =0V, f=1MHz		150		
出力容量 Output Capacitance	C <sub>oss</sub>			340		ns
ターンオン時間 Turn-on Time	t <sub>on</sub>	I <sub>D</sub> =-2.5A, V <sub>GS</sub> =-10V, R <sub>L</sub> =12Ω		55	110	
ターンオフ時間 Turn-off Time	t <sub>off</sub>			260	520	